

PROCESS FOR REMOVAL OF PHOTORESIST AFTER POST ION IMPLANTATION

Publication number: JP2004517475 (T)

Publication date: 2004-06-10

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international: **G03F7/42; H01L21/027; H01L21/304; H01L21/3065; G03F7/42; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/3065; G03F7/42; H01L21/027; H01L21/304**

- European: **G03F7/42**

Application number: JP20020553587T 20011218

Priority number(s): WO2001GB05602 20011218; US20000742721 20001222

Also published as:

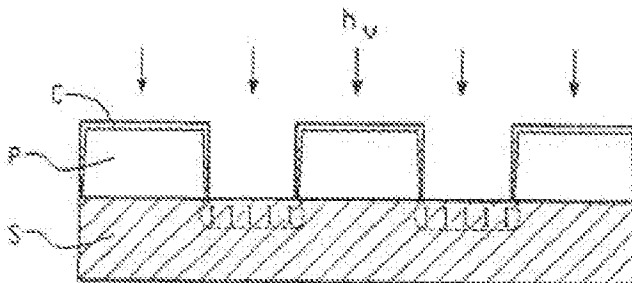
JP3879027 (B2)
WO02052349 (A2)
WO02052349 (A3)
US2002151156 (A1)
US6524936 (B2)

more >>

Abstract not available for JP 2004517475 (T)

Abstract of corresponding document: **WO 02052349 (A2)**

A process for stripping a photoresist layer after exposure to an ion implantation process. The process includes subjecting a substrate having the ion implanted photoresist layer thereon to a UV radiation exposure and subsequently removing the ion implanted photoresist by conventional stripping processes.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2004-517475

(P2004-517475A)

(43) 公表日 平成16年6月10日(2004.6.10)

(51) Int.Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

H O 1 L 21/3065

H O 1 L 21/302 1 O 4 H

2 H O 9 6

G O 3 F 7/42

G O 3 F 7/42

5 F O O 4

H O 1 L 21/027

H O 1 L 21/304 6 4 5 C

5 F O 4 6

H O 1 L 21/304

H O 1 L 21/304 6 4 5 D

H O 1 L 21/304 6 4 7 Z

審査請求 有 予備審査請求 有 (全 33 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-553587(P2002-553587)

(86) (22) 出願日 平成13年12月18日(2001.12.18)

(85) 翻訳文提出日 平成15年6月20日(2003.6.20)

(86) 国際出願番号 PCT/GB2001/005602

(87) 国際公開番号 W02002/052349

(87) 国際公開日 平成14年7月4日(2002.7.4)

(31) 優先権主張番号 09/742,721

(32) 優先日 平成12年12月22日(2000.12.22)

(33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人 500266634

アクセリス テクノロジーズ インコーポ

レーテッド

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 O

1 9 1 5 ベバリー チェリー ヒル ド

ライブ 5 5

(74) 代理人 100068618

弁理士 粁 経夫

(74) 代理人 100104145

弁理士 宮崎 嘉夫

(74) 代理人 100109690

弁理士 小野塚 薫

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イオン注入後にフォトレジストを除去するための処理方法

.....
